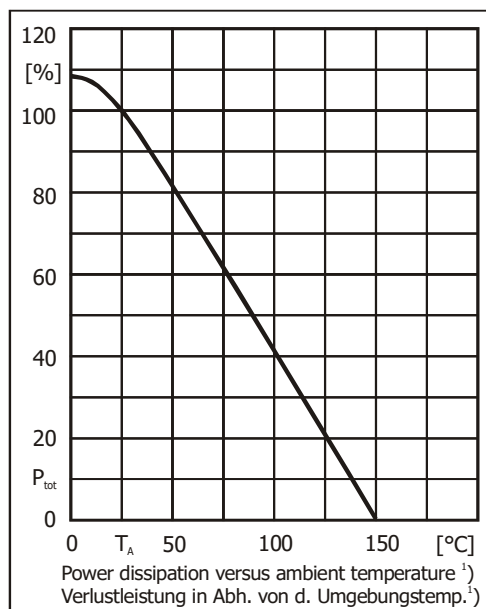


Characteristics
Kennwerte

$T_j = 25^{\circ}\text{C}$		Min.	Typ.	Max.
DC current gain – Kollektor-Basis-Stromverhältnis ¹⁾				
$V_{\text{CE}} = 1\text{ V}, I_{\text{C}} = 100\text{ mA}$	Group -16	100	–	250
	Group -25	160	–	400
	Group -40	250	–	630
$V_{\text{CE}} = 1\text{ V}, I_{\text{C}} = 500\text{ mA}$	h_{FE}	40	–	–
Collector-Emitter saturation voltage – Kollektor-Emitter-Sättigungsspg. ²⁾				
$I_{\text{C}} = 500\text{ mA}, I_{\text{B}} = 50\text{ mA}$	V_{CESat}	–	–	0.7 V
Base-Emitter saturation voltage – Basis-Emitter-Sättigungsspannung ²⁾				
$I_{\text{C}} = 500\text{ mA}, I_{\text{B}} = 50\text{ mA}$	V_{BESat}	–	–	1.3 V
Base-Emitter-voltage – Basis-Emitter-Spannung ²⁾				
$V_{\text{CE}} = 1\text{ V}, I_{\text{C}} = 500\text{ mA}$	V_{BE}	–	–	1.2 V
Collector-Base cutoff current – Kollektor-Basis-Reststrom				
$V_{\text{CB}} = 20\text{ V}, (\text{E open})$	I_{CB0}	–	–	100 nA
$V_{\text{CB}} = 20\text{ V}, T_j = 125^{\circ}\text{C}, (\text{E open})$		–	–	5 μA
Emitter-Base cutoff current – Emitter-Basis-Reststrom				
$V_{\text{EB}} = 4\text{ V}, (\text{C open})$	I_{EB0}	–	–	100 nA
Gain-Bandwidth Product – Transitfrequenz				
$V_{\text{CE}} = 5\text{ V}, I_{\text{C}} = 10\text{ mA}, f = 50\text{ MHz}$	f_{T}	–	100 MHz	–
Collector-Base Capacitance – Kollektor-Basis-Kapazität				
$V_{\text{CB}} = 10\text{ V}, I_{\text{E}} = I_{\text{C}} = 0, f = 1\text{ MHz}$	C_{CBO}	–	12 pF	–
Typical thermal resistance junction to ambient Typischer Wärmewiderstand Sperrschicht – Umgebung		R_{thA}	420 K/W ²⁾	



Disclaimer: See data book page 2 or [website](#)
Haftungsschluss: Siehe Datenbuch Seite 2 oder [Internet](#)

- 1 Tested with pulses $t_p = 300\text{ }\mu\text{s}$, duty cycle $\leq 2\%$ – Gemessen mit Impulsen $t_p = 300\text{ }\mu\text{s}$, Schaltverhältnis $\leq 2\%$
- 2 Mounted on P.C. board with 3 mm^2 copper pad at each terminal
Montage auf Leiterplatte mit 3 mm^2 Kupferbelag (Lötpad) an jedem Anschluss